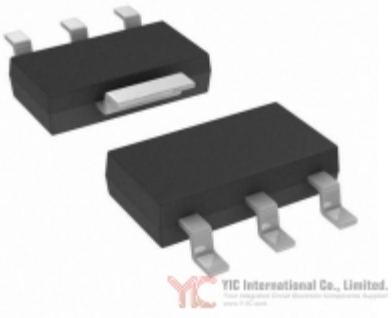







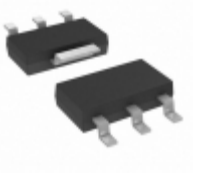
	<h2 style="color: red;">FQT13N06TF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQT13N06TF</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 2.8A SOT-223</p> <p>Datenblätter: 1.FQT13N06TF.pdf 2.FQT13N06TF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 21060 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQT13N06TF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 2.8A SOT-223
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	21060 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 2.8A (Tc) 2.1W (Tc) Surface Mount
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223-4
Verlustleistung (max)	2.1W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	140 mOhm @ 1.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	310pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQT13N06TF-ND

FQT13N06TF ist neu im Original, Suche FQT13N06TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQT13N06TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQT13N06TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQT13N06 FAIRCHI FQT13N06 FAIRCHI</p>	 <p>FQT1N60CTF_WS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 0.2A SOT-223-4</p>	 <p>FQT13N06LTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 2.8A SOT-223</p>	 <p>FQT1N60CTF-NL FAIRCHILD FQT1N60CTF-NL FAIRCHILD</p>
 <p>FQT13N06TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 2.8A SOT-223</p>	 <p>FQT13N06LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 2.8A SOT-223</p>	 <p>FQT1N60C FAIRCHI FQT1N60C FAIRCHI</p>	 <p>FQT1N60CTF-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 0.2A SOT-223-4</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ 1812CC471KAT1A	↔ ACB4532M-202-T	⇒ ADP2140ACPZ18812R7	D ASM809REUR-T	↔ ATA5749C-6DQY-64
⊖ C3216X7R2A104KT	⊕ CL31C222JHHNNNE	D CM36686U	⇒ CQ0603JRNPO9BN430	↔ DIM1200FSM17-A076
⊕ FM24C16A-S	⊖ FQD3N60CS	⊕ FQT13N06	↔ FQT13N06L	↔ FQT13N06LTF
D FQT13N06LTF	⊕ FQT13N06TF	⊖ FQT1N60C	⊕ FQT1N60CTF	↔ FQT1N60CTF-NL
⇒ FQT1N80TF	↔ FQT2P25TF	⊕ FQT2P25TF	⊖ FQT3P20TF	↔ FQT3P20TF
↔ FQT4N20L	⇒ FQT4N20LTF	D FQT4N20LTF	⊕ FQT4N20TF	⊖ FQT4N20TF
⊕ FQT4N25TF	D FQT4N25TF	⇒ FQT5P10TF	↔ FQT5P10TF	↔ FQT7N10L
⊖ FQT7N10LTF	⊕ FQT7N10LTF	↔ FQT7N10TF	⇒ FQT7N10TF	↔ IRLI3215
⊕ LM3916N-1	⊖ MAX3075EESA+T	⊕ MAX548AEUA-T	D P20NM50FD	↔ SI7404DN-T1
↔ SIHFRC20TL-E3	⊕ SN65LVDS83CZQLR	⊖ STD11N65M2	⊕ VI-261-CU	↔ XC6371E501PR

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

